

圖 13-24 0.2 $\mu\text{m}$  通孔電阻量測結果。

#### 13.1.4 閘極氧化層（Gate Dielectric）Integrity 量測

作為 MOS 元件開關最重要的氧化層，如何設計氧化層量測的測試鍵非常重要，一般以氧化層的擊穿電壓強度及漏電流來判斷氧化層的品質，又製程缺陷可能發生於整個氧化層或多晶矽邊緣或主動區邊緣，因此必須設計不同結構以觀察不同區域的氧化層品質。

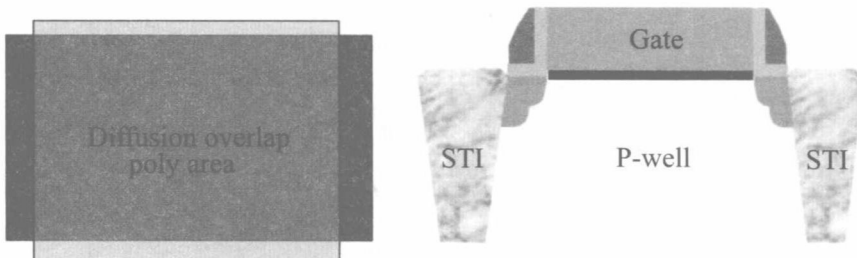


圖 13-25 氧化層測試鍵的平面與截面示意圖。